

## МОДУЛЯТОР МАЛЫХ ПОСТОЯННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА КРЕМНИЕВЫХ ТРИОДАХ

М. С. РОЙТМАН, А. Г. ВАЙСБУРД

(Представлена научным семинаром факультета автоматики и вычислительной техники)

Модуляторы малых постоянных напряжений на полупроводниковых триодах, несмотря на сравнительное обилие различных схемных исполнений, выполняются по двум путям: путем стабилизации режимов работы транзистора [1] или путем тщательного подбора триодов с целью взаимокомпенсации остаточных параметров  $U_p$  и  $I_p$  [2, 3 и др.].

В первом случае необходимо коммутацию осуществлять прямоугольным стабилизированным напряжением и жестко стабилизировать температуру триода [1], что весьма нежелательно.

Во втором — требуется проводить тщательную отбраковку триодов [2, 3], что в условиях серийного производства также нежелательно, а зачастую и недопустимо.

Очевидно, что наилучшим решением явилось бы построение модулятора с малым дрейфом нуля, большим входным сопротивлением, способного работать в широком диапазоне температур, но без необходимости при этом стабилизации температуры триодов или их специальной отбраковки. Ниже приводится один из возможных вариантов такого построения модулятора, в частности, на базе общеизвестной схемы (рис. 1, а) [4].

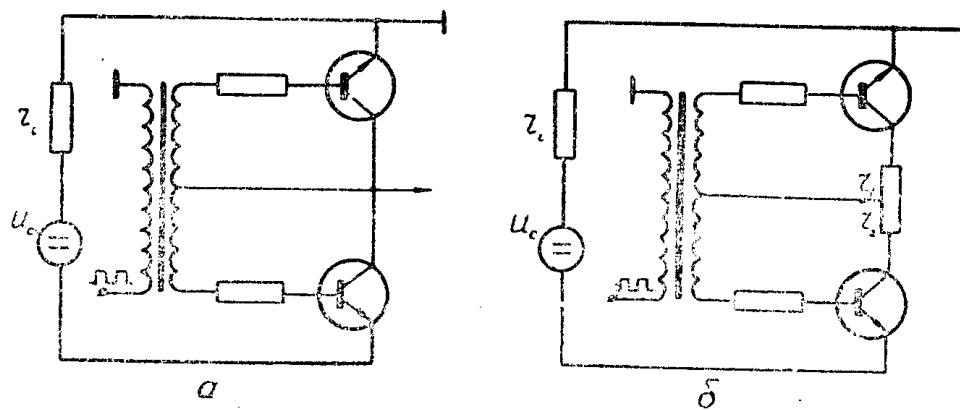


Рис. 1.

Напряжение на выходе такого модулятора при отсутствии входного сигнала равно

$$U_{\text{вых}}(t) \approx \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{U_{p_1} - I_{p_2} r_i - U_{p_2}}{n} \left\{ \left[ 1 - 2 \left( \pi \frac{\Delta T}{T} \right)^2 \cdot \sin n \omega t + \right. \right. \\ \left. \left. + 2 \pi \frac{\Delta T}{T} \cos n \omega t \right] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{T} \left[ \int_0^{\tau_1} U_{b_1}(t) e^{-jn\omega t} dt + \right. \right. \\ \left. \left. \int_{\frac{T}{2} + \Delta T}^{\frac{T}{2} + \Delta T + \tau_2} U_{b_2}(t) e^{-jn\omega t} dt \right] \cdot e^{jn\omega t}, \right.$$

где  $U_{p_1}$  и  $U_{p_2}$  — остаточные напряжения первого и второго триодов;  
 $I_{p_2}$  — остаточный ток второго триода;  
 $r_i$  — внутреннее сопротивление источника;  
 $U_{b_1}(t)$ ,  $U_{b_2}(t)$  — напряжение выбросов, возникающих при запирании триодов;  
 $\tau_1$ ,  $\tau_2$  — длительность выбросов;  
 $T$  — длительность периода;  
 $\frac{\Delta T}{T}$  — относительное неравенство полупериодов.

Считая выбросы прямоугольными,  $U_{b_1} = U_{b_2} = U_b$  и  $\frac{\Delta T}{T} \ll 1$ , можем

определить напряжение первой гармоники частоты коммутации при отсутствии входного сигнала (часто это напряжение именуют „ложным сигналом“)

$$U_{\text{л.с.}} \approx \frac{\sqrt{2}}{\pi} (U_{p_1} - I_{p_2} r_i - U_{p_2}) \left[ 1 - 2 \left( \pi \frac{\Delta T}{T} \right)^2 \right] \sin \omega t + \\ + 2\pi^2 \left[ \frac{\tau_1 - \tau_2}{T} \cdot \frac{\tau_1 + \tau_2}{T} - \frac{2\Delta T \tau_2}{T^2} \right] \cdot \sin \omega t \cdot U_b + 2\pi \frac{\tau_1 - \tau_2}{T} U_b \cos \omega t.$$

Остаточное напряжение  $U_p$  равно [5]

$$U_p = \frac{kT}{q} m \ln \frac{1+\beta}{\beta} + I_b r_k,$$

где  $k$  — постоянная Больцмана;  
 $T$  — абсолютная температура;

$q$  — заряд электрона (для комнатной температуры  $\frac{kT}{q} \approx 26$  мв);

$\beta$  — усиление триода по току в схеме с общим эмиттером;

$I_b$  — ток базы (он равен току коммутации);

$r_k$  — сопротивление полупроводника коллектора;

$m$  — постоянная, определяемая плотностью инжектированного тока в области базы.

Для сплавных германиевых транзисторов (П13–П16)  $m \approx 1$ ,  $r_k < 0,2$  ом и  $U_p$  для качественных триодов находится в пределах 0,3–0,6 мв. Для кремниевых триодов  $m \approx 1,5–2$ ,  $r_k < 1,2$  ом и  $U_p = 0,6–3$  мв.

Очевидно, что с точки зрения величины  $U_p$  предпочтение следует отдавать германиевым триодам. Однако у германиевых триодов  $I_p \geq 2 \cdot 10^{-8} A$  (при  $20^\circ C$ ) и дрейф нуля при сопротивлении источника большем нескольких десятков ом весьма существенно зависит от нестабильности  $I_p$  ( $I_p$  меняется на 7–8 % на  $1^\circ C$ ).

Влияние  $I_p$  можно исключить, осуществляя коммутацию униполярным напряжением. Но в этом случае входное сопротивление резко падает и модулятор на германиевых триодах становится непригодным для работы на повышенных температурах. Поэтому при необходимости работать в широком диапазоне температур и внутреннем сопротивлении источника большем 50 ом предпочтение следует отдавать кремниевым триодам или применять более сложные схемы модуляторов [3].

Проведенные нами исследования показали, что из отечественных кремниевых триодов наилучшими характеристиками обладают МП10ЗА. В табл. 1 приведены данные величины  $\alpha$ ,  $U_p$  и  $I_p$  для шести штук МП10ЗА.

Таблица 1

№ триодов	1	2	3	4	5	6	
$\alpha$	0,978	0,994	0,972	0,983	0,981	0,988	$t = 20^\circ\text{C}$
$U_{p_{MB}}$	1,4	0,8	1,3	1,2	1,2	1,1	$I_6 = 500 \text{ мка}$ $U_6 = 450 \text{ мв}$
$I_p \cdot 10^9 \text{ а}$	2	0,5	1,5	4	1	0,25	$t = 60^\circ\text{C}$ $U_6 = 450 \text{ мв}$

Зависимости  $U_p$  и  $I_p$  от коммутирующего тока ( $I_6$ ) и напряжения ( $U_6$ ) даны на рис. 2, а, б.

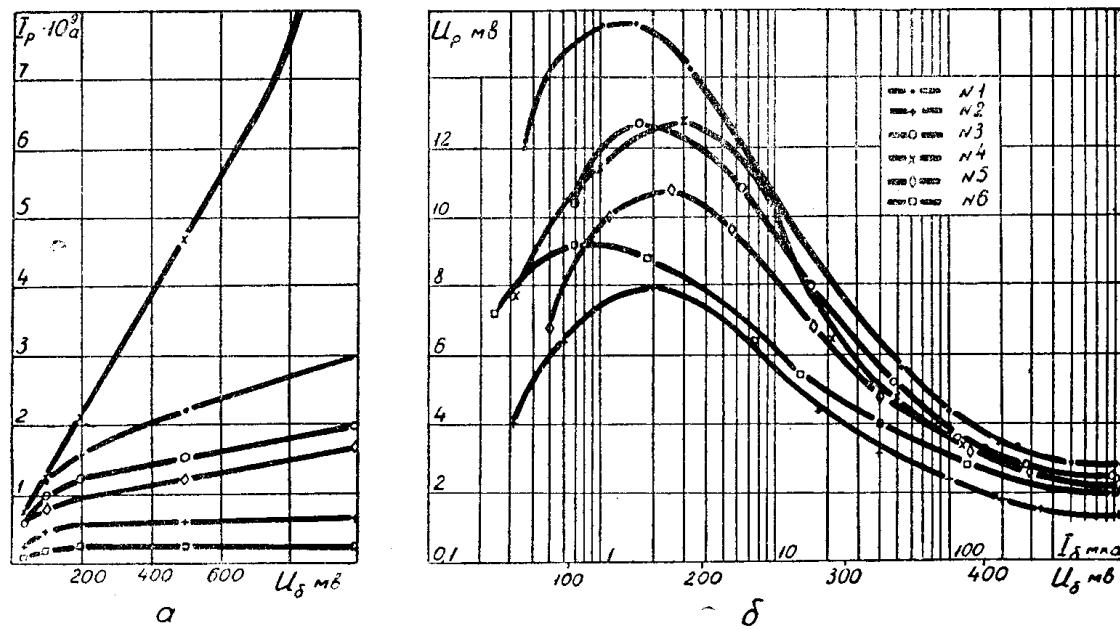


Рис. 2.

Поскольку для  $t = 60^\circ\text{C}$   $I_p \leq 5 \cdot 10^{-9} \text{ а}$ , то при  $r_i \leq 5 \text{ ком}$  на низких частотах  $U_{L.C.} \approx (U_{p_1} - U_{p_2}) \frac{\sqrt{2}}{\pi}$ . Если последовательно с коллекторами включить сопротивления (рис. 1, б), то

$$U_{L.C.} \approx (U_{p_1} + I_k r_1 - U_{p_2} - I_k r_2).$$

Очевидно, что если  $|U_{p_1} - U_{p_2}| < I_k(r_1 + r_2)$ , то меняя соотношение между  $r_1$  и  $r_2$ , т. е. регулируя потенциометр  $R$ , можно свести  $U_{\text{л.с.}}$  к весьма малой величине.

Однако  $I_k$  является функцией коммутирующего напряжения  $U_k$ , а  $U_p = f(U_k, T)$ .

Для оценки реальной величины дрейфа нуля  $U_d$ , т. е. изменения  $U_{\text{л.с.}}$ , необходимо определить влияние различных факторов, прежде всего, изменения температуры и коммутирующего напряжения. Зависимости  $U_{\text{л.с.}} = f(t^\circ\text{C})$  для различных триодов, использованных в практической схеме модулятора (рис. 3) даны в табл. 2.

Таблица 2  
 $U_{\partial \text{мкв}} = f(t^\circ\text{C})$

	22	35	40	50	60
4и1	0	—	—	—	10
4и3	0	15	15	18	18
4и5	0	0	0	2,5	7,5
4и6	0	0	0	—	6
4и2	0	-5	-7,5	-10	-11
1и2	0	—	30	—	66

Экспериментальные данные подтверждают очевидное предположение, что наибольшим дрейфом обладают пары триодов с максимальным отличием остаточных напряжений  $U_p$  (табл. 1). У триодов 1 и 2 весьма существенное различие в коэффициентах усиления по току. Отношение  $\beta_2 > 3,7$  намного превышает допустимое ГОСТом значение для триодов одной группы. Экспериментальная проверка показала, что, если брать триоды МП103А с  $\beta_{\min} \geq 40$  и отношением  $\frac{\beta_{\max}}{\beta_{\min}} \leq 2$ , то при любых комбинациях триодов и условиях коммутации номинальным током дрейф нуля от нагрева до  $60^\circ\text{C}$  меньше 30 мкв (практически находится в пределах  $\pm 20$  мкв).

За номинальное значение коммутирующего тока  $I_b$  нами принято 0,5ма.

Меньшая величина  $I_b$ , как следует из зависимости  $U_p = f(I_b)$  (рис. 2, а), нежелательна. Увеличение  $I_b$  не приводит к существенному уменьшению  $U_p$ , но в то же время вызывает возрастание длительности и амплитуды выбросов при выходе триодов из насыщения<sup>1</sup>).

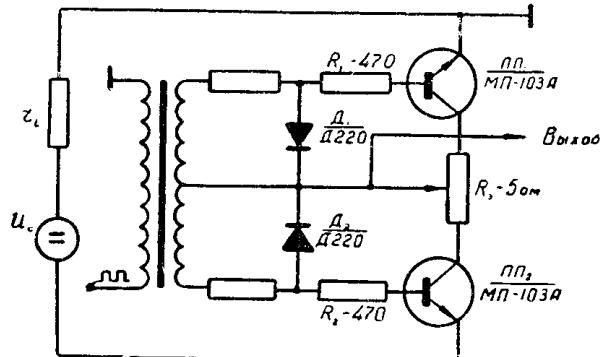


Рис. 3.

<sup>1</sup> Оптимальное значение  $I_b$  определяется не только указанными факторами, но и температурными зависимостями  $U_p = f(t^\circ\text{C})$  для заданного тока  $I_b$ .

При малых токах коммутации температурный коэффициент  $U_p$  отрицателен, при больших ( $I_b > 2$ ) — положителен и, очевидно, в некотором промежутке значений  $I_b$  он минимален.

Изменения коммутирующего напряжения  $U_k$  на  $\pm 5\%$  приводят к дрейфу нуля не более  $\pm 15$  мкв.

Диоды Д220 применены для уменьшения влияния изменений  $U_k$ , а также для улучшения формы кривой напряжения при наличии искажений трансформатора.

Предпочтение отдано диодам Д220, поскольку у них малое динамическое и значительное статическое сопротивления (при токе  $2 \div 5$  ма  $r_d \approx 10$  ом,  $r_{ce} \approx 150$  ом) и прямое напряжение, близкое к оптимальной величине ( $U_{rp} = 0,7 \div 0,8$  в).

Нестабильность коэффициента преобразования входного напряжения практически определяется лишь нестабильностью скважности коммутирующего напряжения.

Если к выходу модулятора подключен усилитель с малым фазовым сдвигом в полосе частот и усиленное напряжение выпрямляется синхронным детектором, коммутирующее напряжение на который подается от того же источника, что и на модулятор, то девиация скважности не меняет коэффициента преобразования входного сигнала.

Входное сопротивление модулятора  $R_{bx} \geq 5$  мом и зависит как от режима работы триодов, так и от температуры окружающей среды. Усредненная зависимость  $R_{bx} = f(t^{\circ}\text{C})$  дана на рис. 4.

С увеличением частоты выходное сопротивление падает (рис. 5). Это обусловлено тем, что при крутых фронтах коммутирующего напряжения ( $t_{\phi+} < t_h$

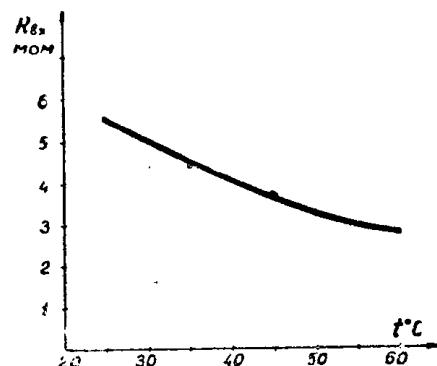


Рис. 4.

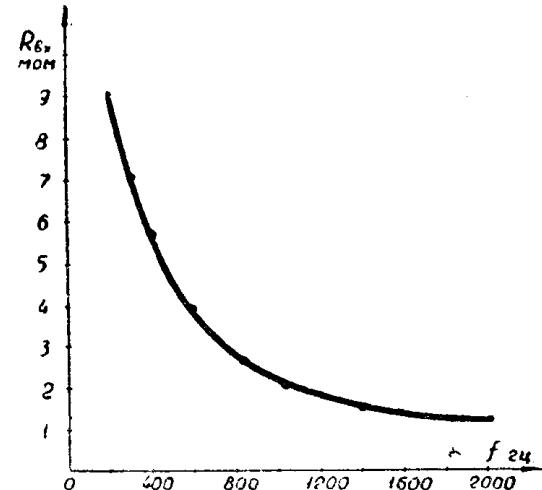


Рис. 5.

и  $t_{\phi-} < t_p + t_c$ ) имеем существенную сквозную проводимость модулятора в течение промежутка времени  $\tau$ , примерно равного

$$t_p + t_c - t_h.$$

где  $t_h$  — время нарастания коллекторного тока;

$t_p$ ,  $t_c$  — соответственно время рассасывания неосновных носителей в базе и время спада.

Очевидно, что с увеличением частоты увеличивается отношение  $\frac{\tau}{T}$ , где  $T$  — длительность периода.

При коммутации триодов синусоидальным напряжением входное сопротивление на частотах  $f \geq 400$  гц выше, однако, существенно увеличивается дрейф нуля ( $\pm 50 \div 60$  мкв) и содержание гармоник на выходе модулятора вследствие возможной неидентичности триодов.

Нами не было проведено детального исследования  $U_p(t^{\circ}\text{C})$  в функции от  $I_6$  для триодов М1103А, хотя выполнение такой работы весьма желательно.

## ЛИТЕРАТУРА

1. I. C. Hutcheon, D. Hemmers. A low-drift transistor chopper-type D.C. amplifier roirth high gain and large dynamic range. IEE.
2. Н. С. Николаенко, В. П. Федотов. Проектирование преобразователей малых сигналов постоянного тока на полупроводниковых триодах. Известия ВУЗов. Приборостроение. № 2. 1962.
3. М. С. Ройтман, А. Н. Кармадонов, Ю. С. Рябинкин, С. А. Гофман. Преобразователи малых э.д.с. постоянного тока на полупроводниковых приборах. Труды II конференции по автоконтролю и электрометрии, Изд. СО АН СССР, Новосибирск, 1962.
4. R. L. Bright, A. P. Kriegel. Electronics, 28, № 4, p. 135—137, 1955.
5. Дж. Каррол. Электронные схемы на полупроводниковых триодах. стр. 71—79. издательство иностранной литературы, 1959.